

**Modulbezeichnung:** Crystal Growth ET (MWT 3) (CGET) 10 ECTS  
(Crystal growth ET)

Modulverantwortliche/r: Peter Wellmann

Lehrende: Uwe Scheuermann, Peter Wellmann

Startsemester: WS 2017/2018 Dauer: 2 Semester Turnus: halbjährlich (WS+SS)  
Präsenzzeit: 110 Std. Eigenstudium: 190 Std. Sprache: Deutsch

### Lehrveranstaltungen:

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie (WS 2017/2018, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

Praktikum Wahlfach Crystal Growth (WS 2017/2018, Praktikum, 3 SWS, Peter Wellmann)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen (Technologie II) (SS 2018, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

### Wahlvorlesungen

Aus den optionalen Wahlveranstaltungen kann eine Vorlesung gewählt werden, die mit 1 ECTS in das Modul eingeht.

Halbleiter großer Bandlücke (SS 2018, optional, Vorlesung, 1 SWS, Peter Wellmann)

Aufbau- und Verbindungstechnik in der Leistungselektronik (WS 2017/2018, optional, Vorlesung, 2 SWS, Uwe Scheuermann)

Numerische Modellierung des Kristallwachstums mithilfe des Programmpakets COMSOL Multi-Physics (SS 2018, optional, Vorlesung mit Übung, 2 SWS, Anwesenheitspflicht, Peter Wellmann)

### Empfohlene Voraussetzungen:

Bachelor in Materialwissenschaft, Nanotechnologie, Energietechnik, Physik, Chemie oder in einem vergleichbaren Studiengang.

### Inhalt:

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie

- Grundlagen des Kristallwachstums
- Grundlagen der Silizium Halbleitertechnologie (Oxidation, Dotierung mittels Diffusion und Ionenimplantation, Ätzen, Metallisierung, Lithografie, Packaging)

Elektronische Bauelemente und Materialfragen

- Korrelation von Bauelementfunktion (Bipolar-Diode, Bipolar-Transistor, Schottky-Diode, Feldeffekt-Transistor, Leucht- und Laserdiode) mit Materialeigenschaften
- Grundlagen Epitaxie

Praktikum

- Czochralski Kristallwachstum von InSb
- Modellierung in der Kristallzüchtung
- Halbleitercharakterisierung

### Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden

- erwerben fundierte Kenntnisse über Materialeigenschaften und deren Anwendungen in elektronischen Bauelementen

-lernen experimentelle Techniken in den Werkstoffwissenschaften kennen und können sie selbständig anwenden

- können in Gruppen kooperativ und verantwortlich arbeiten

### Literatur:

Wird in den Lehrveranstaltungen angegeben.

### Studien-/Prüfungsleistungen:

Crystal Growth ET (MWT 3) (Prüfungsnummer: 991457)

(englische Bezeichnung: Crystal growth ET)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 30

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

weitere Erläuterungen:

zusätzlich Absolvierung des Praktikums!

Erstablesung: WS 2017/2018, 1. Wdh.: SS 2018

1. Prüfer: Peter Wellmann

---